


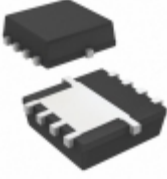






	<b>SIS436DN-T1-GE3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS436DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 22225 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22225 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 27.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	855pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SIS436DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS436DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS436DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS436DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS439DNT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>	 <p><b>SIS436DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SiS436DN</b> Vishay SiS436DN Vishay</p>	 <p><b>SIS439DNT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>
 <p><b>SIS438DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS434DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS4407</b> SIS SIS4407 SIS</p>	 <p><b>SIS438DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>

### SIS436DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS436DN-T1-GE3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited